PAT-NO:

JP411237638A

DOCUMENT-

JP 11237638 A

IDENTIFIER:

TITLE:

PREPARATION OF LIQUID CRYSTAL

· ALIGNMENT FILM

PUBN-DATE:

August 31, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUKI, YASUO N/A

MUTSUKA, YASUAKI N/A

YASUDA, YOSHITOMO N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

JSR CORP N/A

APPL-NO: JP10342952

APPL-DATE: December 2, 1998

INT-CL

G02F001/1337 , C08G073/10 , C08J005/18 ,

(IPC):

C08L079/04 , C08L079/08

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain good display characteristics such as aligning property of liquid crystal molecules and afterimage chara cteristics without rubbing treatment by irradiating an org. thin film containing a soluble polyimide having an alicyclic structure on a substrate with ion beams.

SOLUTION: The liquid crystal alignment film is produced by irradiating an org. thin film c a soluble polyimide having an alicyclic structure formed on a substrate with ion beams. In the ion beams, characteristics alignment treatment with required for the . alignment film are that the film is easily etched with ion beams and that the formed grooves are not deformed. The polyimide having an alicyclic structure satisfies the requirement above described. As the agent for the liquid crystal alignment film, two or more kinds of polymers may be mixed to be used. In this case, the soluble polyimi de having an alicyclic structure or an imide structural unit having an alicyclic structure is preferably included at least by

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-237638

(43)公開日 平成11年(1999)8月31日

G 0 2 F 1/1337 5 2 5 C 0 8 G 73/10 C 0 8 J 5/18 C F G C 0 8 L 79/04 Z
C 0 8 J 5/18 CFG
C 0 8 L 79/04 Z
79/08 A
審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 17)
(71)出願人 000004178
ジェイエスアール株式会社
東京都中央区築地2丁目11番24号
(72)発明者 松木 安生
東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェ
エスアール株式会社内
(72)発明者 六鹿 秦顧
東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェ
エスアール株式会社内
(72)発明者 保田 慶友
東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェ
エスアール株式会社内
(74)代理人 弁理士 大島 正孝

(54) 【発明の名称】 液晶配向膜の調製法

(57)【要約】

【課題】 液晶配向性が良好であり、かつ配向状態が、長時間の駆動後においても良好に保持され、残像現象も生じにくい液晶配向膜を調製する方法を提供すること。 【解決手段】 ラビング処理によらずに、ラビング処理と同レベルに安定した配向能が付与された液晶配向膜の調製法である。この方法では、基板上に形成された、脂環式構造を有する可溶性ポリイミドを含有する有機薄膜にイオンビームを照射する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に形成された、脂環式構造を有す る可溶性ポリイミドを含有する有機薄膜にイオンビーム を照射することを特徴とする、液晶配向膜の調製法。

【請求項2】 脂環式構造を有する可溶性ポリイミドが テトラカルボン酸二無水物とジアミン化合物との反応生 成物であるポリアミック酸を脱水閉環して得られたもの でありそして上記テトラカルボン酸二無水物とジアミン 化合物の少なくとも一方が、酸無水物基またはアミノ基 が脂環式構造に直接結合した化合物を含有する請求項1 10 素子を構成する液晶配向膜の材料としては、従来より、 の調製法。

【請求項3】 テトラカルボン酸二無水物が、酸無水物 基が脂環式構造に直接結合したテトラカルボン酸二無水 物を少なくとも含有する請求項2の調製法。

【請求項4】 テトラカルボン酸二無水物が、酸無水物 基が脂環式構造に直接結合したテトラカルボン酸二無水 物と、酸無水物基が脂環式構造に直接結合していないテ トラカルボン酸二無水物との組合せである請求項3の調 製法。

造に直接結合したジアミン化合物を少なくとも含有する 請求項2の調製法。

【請求項6】 ジアミン化合物が、アミノ基が脂環式構 造に直接結合したジアミン化合物と、アミノ基が脂環式 構造に直接結合していないジアミン化合物との組合せで ある請求項5の調製法。

【請求項7】 脂環式構造を有する可溶性ポリイミドが 酸一無水物、モノアミン化合物およびモノイソシアネー ト化合物よりなる群から選ばれる一官能性化合物により 分子末端が修飾された封止されている請求項1の調製

【請求項8】 脂環式構造を有する可溶性ポリイミドの 対数粘度が0.05~10dl/g(N-メチル-2-ピロリドン中、0.5g/100mlの濃度で30℃で 測定)の範囲にある請求項1の調製法。

【請求項9】 脂環式構造を有する可溶性ポリイミドを 含有する有機薄膜が0.001~1 μmの厚みを有する 請求項1の調製法。

【請求項10】 イオンビームのイオン種が窒素、ヘリ ウム、アルゴンネオンの如き水溶性ガスである請求項1 の調製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示素子の液 晶配向膜の調製法に関する。さらに詳しくは、液晶配向 性が良好であり、かつ配向状態が、長時間の駆動後にお いても良好に保持され、残像現象も生じにくい液晶配向 膜を調製する方法に関する。

[0002]

表面に形成されている2枚の基板の間に、正の誘電異方 性を有するネマチック型液晶の層を形成してサンドイッ チ構造のセルとし、前記液晶分子の長軸が一方の基板か ら他方の基板に向かって連続的に90度捻れるようにし たTN (Twisted Nematic)型液晶セル を有するTN型液晶表示素子が知られている。このTN 型液晶表示素子などの液晶表示素子における液晶の配向 は、通常、ラビング処理により液晶分子の配向能が付与 された液晶配向膜により実現される。ここに、液晶表示 ポリイミド、ポリアミドおよびポリエステルなどの樹脂 が知られている。特にポリイミドは、耐熱性、液晶との 親和性、機械的強度などに優れているため多くの液晶表 示素子に使用されている。

【0003】しかしながら、高精細な液晶表示素子にお いてはラビング処理工程におけるダストの除去、大型液 晶表示素子においては、表示面を均一にムラなくラビン グすることに限界があり、様々な表示不良問題を引き起 こす原因とされてきた。ラビングに代わる配向処理方法 【請求項5】 ジアミン化合物が、アミノ基が脂環式構 20 としては、日本国特許第260,866号公報に示され ているような偏向紫外線を配向膜に照射する方法や、日 本国特開平6-130,391号公報などに示されてい るようなイオンビームを配向膜に照射する方法が提案さ れている。しかし、偏光紫外線による配向処理方法は、 配向状態が熱によって緩和しやすいという問題がある。 【0004】一方、イオンビーム法は加速したイオンを 有機膜に衝突させる方法であり、残像特性悪化の原因と されるイオンを有機膜中に作用させるので、残像特性に 問題があること、また、イオンビーム照射による表面変 30 化により、局所的に配向不良が生じるという問題もあ る。イオンビーム法に有効な配向剤としては、日本国特 開平8-313,912号公報、同8-313,913 号公報および同8-313,916号公報に提案されて いるが、上記問題点の解決には不十分である。また、こ れら既に提案されている配向剤は、高温での焼成工程を 要し、基板の耐熱性に制限が生じるという問題がある。 [0005]

> 【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ラビ ング処理によらずに、ラビング処理と同レベルに安定し た配向能が付与された液晶配向膜の調製法を提供するこ とにある。本発明の他の目的は、液晶分子の配向膜、残 像特性などの表示特性が良好な液晶配向膜の調製法を提 供することにある。

【0006】本発明のさらに他の目的は、基板の耐熱性 を問わず、低温での焼成で得ることができる液晶配向膜 の調製法を提供することにある。本発明のさらに他の目 的および利点は、以下の説明から明らかになろう。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、本発明 【従来の技術】従来、透明導電膜を介して液晶配向膜が 50 の上記目的および利点は、基板上に形成された、脂環式

構造を有する可溶性ポリイミドを含有する有機薄膜にイ オンビームを照射することを特徴とする、液晶配向膜の 調製法によって達成される。

【0008】イオンビームによる配向処理の原理は、 「配向膜にイオンビームを照射することによって、配向 膜上に微細な溝が形成され、液晶分子はこの溝の角度、 方向によって立体的な規制を受けて配向する」ものと考 えられる。従って、配向膜に要求される特性は、Oイオ ンピームによって、容易にエッチングされること。②形 成された溝が変形しないこと、つまり、熱などの外的刺 10 激によって分子鎖が運動しにくいことである。本発明で は、上述要求特性を考慮して、鋭意検討を重ねた結果、 脂環式構造を有するポリイミドがこの要求を満たしてい ることを究明し、上記本発明に到達した。

【0009】以下、本発明に関して、具体的に説明す る。本発明に用いられる液晶配向剤は、重合体を2種以 上混合して用いてもよい。このうち、脂環式構造を有す る可溶性ポリイミドもしくは脂環式構造を有するイミド 構造単位を、液晶配向剤の固形分中少なくとも10重量 %以上である。10重量%未満では、本発明の目的性能 (特に低温焼成)が達成できにくい。

【0010】本発明に用いることのできる可溶性ポリイ ミドの製法について述べる。本発明に用いられる可溶性 ポリイミドは、テトラカルボン酸二無水物とジアミン化 合物とを有機溶剤中で反応させてポリアミック酸を合成 し、さらに必要に応じて該ポリアミック酸を脱水閉環し て得ることができる。これらテトラカルボン酸二無水物 とジアミン化合物とのうち少なくとも1つ、好ましくは に直接結合したものを用いる。

【0011】[テトラカルボン酸二無水物]酸無水物基 が脂環式構造に直接結合したテトラカルボン酸二無水物 としては、例えば、1,2,3,4-シクロブタンテトラ カルボン酸二無水物、1,2-ジメチル-1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,3-ジメ チルー1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二 無水物、1,3-ジクロロ-1,2,3,4-シクロブタン テトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-テトラメチ *

$$R^1$$

$$\bigcap_{R'} R' - \bigcap_{R'} R'$$

*ルー1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無 水物、1,2,3,4-シクロペンタンテトラカルボン酸 二無水物、1,2,4,5-シクロヘキサンテトラカルボ ン酸二無水物、3,3',4,4'ージシクロヘキシルテ トラカルボン酸二無水物、2,3,5ートリカルボキシシ クロペンチル酢酸二無水物、3,5,6-トリカルボキシ ノルボルナン-2-酢酸二無水物、2,3,4,5-テト ラヒドロフランテトラカルボン酸二無水物、1,3,3 5-ジオキソ-3-フラニル) -ナフト [1.2-c] -752-1,3-372, 1,3,3a,4,5,9b--キサヒドロー5ーメチルー5 (テトラヒドロー2,5ー ジオキソー3ーフラニル) ーナフト [1,2-c]ーフ $5 \times -1, 3 - 5 \times 1, 3, 3a, 4, 5, 9b - 5 \times 1$ ヒドロー5ーエチルー5 (テトラヒドロー2,5ージオ キソー3-フラニル) -ナフト[1,2-c]-フラン -1,3-ジオン、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒド ロー7ーメチルー5 (テトラヒドロー2,5ージオキソ %以上含むことが好ましく、さらに好ましくは20重量 20 3-ジオン、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒドロー 7-エチルー5 (テトラヒドロー2,5-ジオキソー3 -フラニル) -ナフト [1,2-c] -フラン-1,3-ジオン、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒドロ-8-メチルー5 (テトラヒドロー2,5ージオキソー3ーフ ラニル) -ナフト [1,2-c] -フラン-1,3-ジオ ν , 1, 3, 3a, 4, 5, 9b $- \lambda + \psi + \nu - 8 - x + \psi$ ルー5 (テトラヒドロー2,5-ジオキソー3-フラニ ル) -ナフト[1,2-c] -フラン-1,3-ジオン、 $1,3,3a,4,5,9b-\Delta+b+1-5,8-3+5$ テトラカルボン酸二無水物に、酸無水物基が脂環式構造 30 ルー5(テトラヒドロー2,5-ジオキソー3-フラニ ν) -ナフト [1,2-c] -フラン-1,3-ジオン、 5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフラル)-3-メ チルー3-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸二無 水物、ビシクロ[2,2,2]ーオクトー7ーエン-2, 3,5,6-テトラカルボン酸二無水物、下記式(I)お よび(II)で表される化合物などが挙げられる。

[0012] 【化1】

(I)

(II)

【0013】(式中、R1およびR3は、芳香環を有する 2価の有機基を示し、R2およびR4は、水素原子または アルキル基を示し、複数存在するR²およびR⁴は、それ ぞれ同一でも異なっていてもよい。) 【0014】 これらのうち、1,2,3,4 - シクロブタ

ンテトラカルボン酸二無水物、1,2-ジメチル-1、 2.3.4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、 1,3-ジメチル-1,2,3,4-シクロブタンテトラカ ルボン酸二無水物、1,2,3,4-テトラメチル-1, 2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、 2.3.5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水 物、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒドロー5 (テト ラヒドロー2,5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト [1.2-c] -75y-1.3-yty, 1.3.3a, 4,5,96-ヘキサヒドロー5-メチルー5 (テトラヒ ドロー2,5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト[1, 2-c] -75y-1, 3-y + y, 1, 3, 3a, 4, 5.9b-ヘキサヒドロー5-エチルー5 (テトラヒドロー 2.5-ジオキソー3-フラニル) ーナフト[1,2--ヘキサヒドロー7ーメチルー5 (テトラヒドロー2, 5-ジオキソ-3-フラニル) -ナフト [1,2-c] -792-1,3-532キサヒドロー7ーエチルー5 (テトラヒドロー2.5-ジオキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]ーフ ラン-1,3-ジオン、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサ ヒドロー8-メチルー5 (テトラヒドロー2,5-ジオ キソー3-フラニル) -ナフト [1,2-c] -フラン -1,3-ジオン、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒド ロー8ーエチルー5 (テトラヒドロー2,5ージオキソ -3-フラニル) -ナフト[1,2-c]-フラン-1, 3-35,8-ジメチルー5 (テトラヒドロー2,5-ジオキソ -3-79 -3-79 -79 -79 -79 -13-ジオン、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフラ ル) -3-メチル-3-シクロヘキセン-1,2-ジカ ルボン酸二無水物が好ましく、1,2,3,4-シクロブ タンテトラカルボン酸二無水物、1,2-ジメチル-1. 2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、 1,3-3ルボン酸二無水物、2,3,5-トリカルボキシシクロペ ンチル酢酸二無水物、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサ

ヒドロー5 (テトラヒドロー2,5-ジオキソー3-フ ラニル) -ナフト [1,2-c] -フラン-1,3-ジオ ン、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒドロ-5-メチ ルー5 (テトラヒドロー2,5-ジオキソー3-フラニ ル) ~ナフト [1, 2 - c] ~フラン~1, 3 ~ジオンが 特に好ましい。

【0015】酸無水物基が脂環式構造に直接結合してい ないテトラカルボン酸二無水物としては、ピロメリット 酸二無水物、3,3',4,4'ーベンゾフェノンテトラ 10 カルボン酸二無水物、3,3',4,4'ーピフェニルス ルホンテトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8-ナフ タレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-ナフ タレンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、3, 3',4,4'ージメチルジフェニルシランテトラカルボ ン酸二無水物、3,3',4,4'ーテトラフェニルシラ ンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-フランテ トラカルボン酸二無水物、4,4'ービス(3,4ージカ ルボキシフェノキシ)ジフェニルスルフィド二無水物。 c] - フラン-1,3-ジオン、1,3,3a,4,5,9b 20 4,4'-ビス(3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフ ェニルスルホン二無水物、4,4'ービス(3,4ージカ ルボキシフェノキシ)ジフェニルプロパン二無水物、 3,3',4,4'-パーフルオロイソプロピリデンジフ タル酸二無水物、3,3',4,4'ービフェニルテトラ カルボン酸二無水物、ビス (フタル酸) フェニルホスフ ィンオキサイド二無水物、p-フェニレンービス (トリ フェニルフタル酸) 二無水物、m-フェニレンービス (トリフェニルフタル酸) 二無水物、ピス (トリフェニ ルフタル酸) -4,4' -ジフェニルエーテル二無水 30 物、ビス (トリフェニルフタル酸) -4,4' -ジフェ ニルメタン二無水物、エチレングリコールービス(アン ヒドロトリメリテート)、プロピレングリコールービス (アンヒドロトリメリテート)、1,4-ブタンジオー ルービス (アンヒドロトリメリテート)、1.6-ヘキ サンジオールービス (アンヒドロトリメリテート) 1,8-オクタンジオールービス (アンヒドロトリメリ テート)、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プ ロパンービス(アンヒドロトリメリテート)、下記式 (1)~(4)で表される化合物などが挙げられる。

[0016] 【化2】

【0017】[ジアミン化合物] アミノ基が脂環式構造 に直接結合したジアミン化合物としては、例えば1,4 ージアミノシクロヘキサン、イソホロンジアミン、テト ラヒドロジシクロペンタジエニレンジアミン、ヘキサヒ ドロー4,7-メタノインダニレンジメチレンジアミ *50 い化合物としては、p-フェニレンジアミン、m-フェ

*ン、トリシクロ[6.2.1.02.7] -ウンデシレンジメ チルジアミン、4,4'ーメチレンビス(シクロヘキシ ルアミン) などが挙げられる。

【0018】アミノ基が脂環式構造に直接結合していな

ニレンジアミン、4,4'ージアミノジフェニルメタ ン、4,4'ージアミノジフェニルエタン、4,4'ージ アミノジフェニルスルフィド、4,4'ージアミノジフ ェニルスルホン、3,3'ージメチルー4,4'ージアミ ノビフェニル、4,4'ージアミノベンズアニリド、4. 4'ージアミノジフェニルエーテル、1,5ージアミノ ナフタレン、3,3-ジメチル-4,4' -ジアミノビフ ェニル、5-アミノ-1-(4'-アミノフェニル)-1,3,3-トリメチルインダン、6-アミノ-1-ダン、3,4'ージアミノジフェニルエーテル、3,3' ージアミノベンゾフェノン、3,4'ージアミノベンゾ フェノン、4,4'ージアミノベンゾフェノン、2,2ー ピス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパ ン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェ ニル] ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-ア ミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、 1,4-ピス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1,3 ービス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1,3-ビ ス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、9,9-ビス (4-r)**2,7-ジアミノフルオレン、9,9-ビス (4-アミノ** フェニル) フルオレン、4,4'ーメチレンービス(2 **−クロロアニリン)、2,2',5,5'−テトラクロロ** -4,4'-ジアミノビフェニル、2,2'-ジクロロー 4,4'ージアミノー5,5'ージメトキシビフェニル、 1,4,4'-(p-フェニレンイソプロピリデン) ピス アニリン、4,4'-(m-フェニレンイソプロピリデ ン) ビスアニリン、2,2'ービス[4-(4-アミノ -2-トリフルオロメチルフェノキシ) フェニル] ヘキ サフルオロプロパン、4,4' -ジアミノ-2,2' -ビ ス (トリフルオロメチル) ピフェニル、4,4'ービス [(4-アミノー2-トリフルオロメチル)フェノキ シ] ーオクタフルオロビフェニルなどの芳香族ジアミ ン;1,1-メタキシリレンジアミン、1,3-プロパン ジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジ*

*アミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジア ミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミ ン、4,4-ジアミノヘプタメチレンジアミンなどの脂 肪族ジアミン;2,3ージアミノピリジン、2,6ージア ミノピリジン、3,4-ジアミノピリジン、2,4-ジア ミノピリミジン、5,6ージアミノー2,3ージシアノピ ラジン、5,6ージアミノー2,4ージヒドロキシピリミ 5ートリアジン、1,4ービス(3ーアミノプロピル) (4'-アミノフェニル)-1,3,3-トリメチルイン 10 ピペラジン、2,4-ジアミノ-6-イソプロポキシー 1,3,5-シー1,3,5ートリアジン、2,4ージアミノー6ーフ ェニルー1,3,5ートリアジン、2,4ージアミノー6 5-トリアジン、4,6-ジアミノ-2-ビニル-s-トリアジン、2,4-ジアミノ-5-フェニルチアゾー ν 、2,6-ジアミノプリン、5,6-ジアミノー1,3 ージメチルウラシル、3,5ージアミノー1,2,4ート リアゾール、6,9ージアミノー2ーエトキシアクリジ 20 ンラクテート、3,8-ジアミノー6-フェニルフェナ ントリジン、1,4-ジアミノピペラジン、3,6-ジア ミノアクリジン、ビス (4-アミノフェニル) フェニル アミンおよび下記式 (III) ~ (IV) で表される化合物 などの、分子内に2つの1級アミノ基および該1級アミ ノ基以外の窒素原子を有するジアミン:

[0019]

【化3】

$$X - R^5$$

$$NH_2$$

(式中、R5は、ピリジン、ピリミジン、トリアジン、 ピペリジンおよびピペラジンから選ばれる窒素原子を含 む環構造を有する1価の有機基を示し、Xは2価の有機 基を示す。)

[0020]

【化4】

$$H_2N$$
 $X - R^6 - X$ NH_2 $([V])$

(式中、R⁶は、ピリジン、ピリミジン、トリアジン、 ピペリジンおよびピペラジンから選ばれる窒素原子を含 む環構造を有する2価の有機基を示し、Xは2価の有機 基を示し、複数存在するXは、同一でも異なっていても よい。)

【0021】下記式(V)で表されるモノ置換フェニレ ンジアミン類; 下記式 (VI) で表されるジアミノオルガ ノシロキサン:

%[0022]

[化5]
$$R' - R^8$$

$$NH_2$$

$$(V)$$

(式中、R⁷は、-O-、-COO-、-OCO-、-※50 NHCO-、-CONH-および-CO-から選ばれる

12

2価の有機基を示し、R8は、ステロイド骨格、トリフ *す。) ルオロメチル基およびフルオロ基から選ばれる基を有す [0023] る1価の有機基または炭素数6~30のアルキル基を示* 【化6】

$$H_{2}N + \left(CH_{2}\right)_{p} = \begin{cases} R^{9} & R^{9} \\ SI & \left(CH_{2}\right)_{p} \\ R^{9} & R^{9} \end{cases}$$
 (VI)

(式中、R9は炭素数1~12の炭化水素基を示し、複 く、pは1~3の整数であり、qは1~20の整数であ

※などを挙げることができる。これらのジアミン化合物 数存在するR^gは、それぞれ同一でも異なっていてもよ 10 は、単独でまたは2種以上組み合わせて用いることがで きる。

[0025]

【0024】下記式(9)~(21)で表される化合物※

【化7】

H₂N
$$\longrightarrow$$
 COO \longrightarrow CH₃ \longrightarrow CH₃

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3

(式中、yは2~12の整数であり、zは1~5の整数 * [0026] である。) 【化8】

$$H_2N$$
— NH_2 (14)

$$H_2N - N - CH_2$$
 $N - NH_2$ (15)

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3

$$H_{3}C \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3}CH=C \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3}$$

$$H_{3}C \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3}CH=C \xrightarrow{CH_{3}} CH=C \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3}CH=C \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3}CH=C$$

[0027]

* *【化9】

17
$$CF_3$$
 (20)

 H_2N OOC OOC

【0028】これらのうち、1.4-ジアミノシクロへ キサン、イソホロンジアミン、テトラヒドロジシクロペ ンタジエニレンジアミン、ヘキサヒドロー4.7ーメタ ノインダニレンジメチレンジアミン、トリシクロ「6. $2.1.0^{2.7}$] -ウンデシレンジメチルジアミン、4, 4'ーメチレンピス(シクロヘキシルアミン)、4. 4'ージアミノジフェニルスルフィド、4,4'ージア ミノジフェニルスルホン、pーフェニレンジアミン、 4,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミ 20 ノジフェニルエタン、3,3'ージメチルー4,4'ージ アミノビフェニル、2.2-ビス「4-(4-アミノフ ェノキシ) フェニル] プロパン、1,4-ビス (4-ア ミノフェノキシ) ベンゼン、1,3-ビス (4-アミノ フェノキシ) ベンゼン、1,3-ビス (3-アミノフェ ノキシ) ベンゼン、9,9-ビス (4-アミノフェニ ル) -10-ヒドロアントラセン、2,7-ジアミノフ ルオレン、9,9-ピス(4-アミノフェニル)フルオ レン、3,3'ージメトキシー4,4'ージアミノビフェ ニル、1,4,4'-(p-フェニレンイソプロピリデ ン) ビスアニリン、4,4'-(m-フェニレンイソプ ロピリデン) ビスアニリン、1,1-メタキシリレンジ アミン、1,3-プロパンジアミン、テトラメチレンジ アミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジア ミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミ ン、ノナメチレンジアミン、4,4-ジアミノヘプタメ チレンジアミン、上記式(9)~(21)で表される化 合物が好ましい。

【0029】[ポリアミック酸の合成] ポリアミック酸 はテトラカルボン酸二無水物とジアミン化合物とを反応 40 させることにより製造される。その際、テトラカルボン 酸二無水物とジアミン化合物の少なくとも一方が、酸無 水物基が脂環式構造に直接結合した化合物を含有する必 要がある。

【0030】すなわち、その態様としては、

(i). テトラカルボン酸二無水物が、酸無水物基が 脂環式構造に直接結合したテトラカルボン酸二無水物を 少なくとも含有する。例えばテトラカルボン酸二無水物 が、酸無水物基が脂環式構造に直接結合したテトラカル *水物基が脂環式構造に直接結合していないテトラカルボ ン酸二無水物との組合せからなる。

(ii). ジアミン化合物が、アミノ基が脂環式構造 に直接結合したジアミン化合物を少なくとも含有する。 例えばジアミン化合物が、アミノ基が脂環式構造に直接 結合したジアミン化合物のみからなるか、あるいはそれ と、アミノ基が脂環式構造に直接結合していないジアミ ン化合物との組合せからなる。

【0031】ポリアミック酸の合成反応に供されるテト ラカルボン酸二無水物とジアミン化合物の使用割合は、 ジアミン化合物に含まれるアミノ基1当量に対して、テ トラカルボン酸二無水物の酸無水物基が0.2~2当量 となる割合が好ましく、さらに好ましくは0.3~1.2 当量となる割合である。

【0032】ポリアミック酸の合成反応は、有機溶媒中 において、通常-20~150℃、好ましくは0~10 0℃の温度条件下で行われる。ここで、有機溶媒として は、合成されるポリアミック酸を溶解できるものであれ 30 ば特に制限はなく、例えばN-メチル-2-ピロリド ン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホ ルムアミド、ジメチルスルホキシド、アーブチロラクト ン、テトラメチル尿素、ヘキサメチルホスホルトリアミ ドなどの非プロトン系極性溶媒:m-クレゾール、キシ レノール、フェノール、ハロゲン化フェノールなどのフ ェノール系溶媒を例示することができる。また、有機溶 媒の使用量(a)は、通常、テトラカルボン酸二無水物 およびジアミン化合物の総量(b)が、反応溶液の全量 (a+b) に対して0.1~30重量%になるような量 であることが好ましい。

【0033】なお、前記有機溶媒には、ポリアミック酸 の貧溶媒であるアルコール類、ケトン類、エステル類、 エーテル類、ハロゲン化炭化水素類、炭化水素類など を、生成するポリアミック酸が析出しない範囲で併用す ることができる。かかる貧溶媒の具体例としては、例え ばメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピル アルコール、シクロヘキサノール、エチレングリコー ル、プロピレングリコール、1,4-ブタンジオール、 トリエチレングリコール、エチレングリコールモノメチ ボン酸二無水物のみからなるか、あるいはそれと、酸無*50 ルエーテル、乳酸エチル、乳酸ブチル、アセトン、メチ

ルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキ サノン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、メチル メトキシプロピオネート、エチルエトキシプロピオネー ト、シュウ酸ジエチル、マロン酸ジエチル、ジエチルエ ーテル、エチレングリコールメチルエーテル、エチレン グリコールエチルエーテル、エチレングリコールー n -プロピルエーテル、エチレングリコールーiープロピル エーテル、エチレングリコールーnーブチルエーテル、 エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコ ールエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコール 10 ジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエー テル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエ チレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリ コールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリ コールモノエチルエーテルアセテート、テトラヒドロフ ラン、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,4 ージクロロブタン、トリクロロエタン、クロルベンゼ ン、ロージクロルベンゼン、ヘキサン、ヘプタン、オク タン、ベンゼン、トルエン、キシレンなどを挙げること ができる。

【0034】以上のようにして、ボリアミック酸を溶解してなる反応溶液が得られる。そして、この反応溶液を大量の貧溶媒中に注いで析出物を得、この析出物を減圧下乾燥することによりポリアミック酸を得ることができる。また、このボリアミック酸を再び有機溶媒に溶解させ、次いで貧溶媒で析出させる工程を1回または数回行うことにより、ボリアミック酸を精製することができる。

【0035】[ボリイミドの合成] 本発明に用いられる 可溶性ポリイミドは、上記ポリアミック酸を脱水閉環す ることにより調製することができる。ポリアミック酸の脱水閉環は、(i)ポリアミック酸を加熱する方法により、または(ii)ポリアミック酸を有機溶媒に溶解し、この溶液中に脱水剤および脱水閉環触媒を添加し必要に応じて加熱する方法により行われる。また、本発明の液晶配向剤には、部分的に脱水閉環反応したポリイミドも好適に用いることができる。

【0036】上記(i)のポリアミック酸を加熱する方法における反応温度は、通常50~200℃とされ、好ましくは60~170℃とされる。反応温度が50℃未 40満では脱水閉環反応が十分に進行せず、反応温度が200℃を超えると得られるポリイミドの分子量が低下することがある。

【0037】一方、上記(ii)のポリアミック酸の溶液中に脱水剤および脱水閉環触媒を添加する方法において、脱水剤としては、例えば無水酢酸、無水プロピオン酸、無水トリフルオロ酢酸などの酸無水物を用いることができる。脱水剤の使用量は、ポリアミック酸の繰り返し単位1モルに対して0.01~20モルとするのが好ましい。また、脱水閉環触媒としては、例えばピリジ

ン、コリジン、ルチジン、トリエチルアミンなどの3級アミンを用いることができる。しかし、これらに限定されるものではない。脱水閉環触媒の使用量は、使用する脱水剤1モルに対して0.01~10モルとするのが好ましい。なお、脱水閉環反応に用いられる有機溶媒としては、ポリアミック酸の合成に用いられるものとして例示した有機溶媒を挙げることができる。そして、脱水閉環反応の反応温度は、通常0~180℃、好ましくは10~150℃とされる。また、このようにして得られる反応溶液に対し、ポリアミック酸の精製方法と同様の操作を行うことにより、ポリイミドを精製することができる

【0038】 [末端修飾型重合体の合成] 本発明に用い られる液晶配向剤を構成する重合体は、分子量が調節さ れた末端修飾型のものであってもよい。この末端修飾型 の重合体を用いることにより、木発明の効果が損われる ことなく液晶配向剤の塗布特性などを改善することがで きる。このような末端修飾型のものは、ポリアミック酸 を合成する際に、酸一無水物、モノアミン化合物、モノ イソシアネート化合物などを反応系に添加することによ り合成することができる。ここで、酸一無水物として は、例えば無水マレイン酸、無水フタル酸、無水イタコ ン酸、n-デシルサクシニック酸無水物、n-ドデシル サクシニック酸無水物、nーテトラデシルサクシニック 酸無水物、n-ヘキサデシルサクシニック酸無水物など を挙げることができる。また、モノアミン化合物として は、例えばアニリン、シクロヘキシルアミン、nーブチ ルアミン、nーペンチルアミン、nーヘキシルアミン、 n-ヘプチルアミン、n-オクチルアミン、n-ノニル アミン、nーデシルアミン、nーウンデシルアミン、n ードデシルアミン、nートリデシルアミン、nーテトラ デシルアミン、nーペンタデシルアミン、nーヘキサデ シルアミン、n-ヘプタデシルアミン、n-オクタデシ ルアミン、n-エイコシルアミン、3-アミノプロピル トリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシ シラン、2-アミノプロピルトリメトキシシラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-ウレイドプロ ピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエ トキシシラン、 N-(2-アミノエチル)-3-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチ ル) -3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3 ーアミノプロピルジメチルエトキシシラン、3ーアミノ プロピルメチルジエトキシシラン、p-[N-(2-ア ミノエチル) アミノメチル] フェネチルトリメトキシシ ラン、N,N-ビス [3-(トリメトキシシリル)プロ ピル] エチレンジアミン、N-3-トリメトキシシリル プロピルーmーフェニレンジアミンなどを挙げることが できる。また、モノイソシアネート化合物としては、例 えばフェニルイソシアネート、ナフチルイソシアネー 50 ト、3-イソシアナートプロピルトリエトキシシランな

どを挙げることができる。

【0039】 [重合体の対数粘度] 本発明に用いられる 液晶配向剤を構成する重合体は、その対数粘度(ヵ1 n) の値が、好ましくは0.05~10d1/g、さら に好ましくは $0.05\sim5$ d 1/g のものである。ここ に、対数粘度 (n l n) の値は、N-メチル-2-ピロ*

 $n \mid n =$

*リドンを溶媒として用い、重合体の濃度が0.5g/1 00ミリリットルである溶液について30℃で粘度の測 定を行い、下記式(1)で示される式によって求められ るものである。

... (1)

22

[0040]

【数1】

1 n(溶液液下時間/溶媒流下時間)

(ポリマーの重量濃度)

【0041】 [液晶配向剤] 本発明に用いられる液晶配 10※キシカルボニルー3-アミノプロピルトリエトキシシラ 向剤における重合体の含有割合は、粘性、揮発性などを 考慮して選択されるが、好ましくは液晶配向剤全体に対 して0.1~20重量%、さらに好ましくは1~10重 量%の範囲とされる。すなわち、重合体溶液からなる液 晶配向剤は、印刷法、スピンコート法などにより基板表 面に塗布され、次いでこれを乾燥することにより、配向 膜材料である被膜が形成されるが、重合体の含有割合が 0.1重量%未満である場合には、この被膜の膜厚が過 少となって良好な液晶配向膜を得ることができない場合 があり、20重量%を越える場合には、被膜の膜厚が過 20 大となって良好な液晶配向膜を得難く、また、液晶配向 剤の粘度が増大して塗布特性に劣るものとなる場合があ

【0042】なお、本発明で用いられる液晶配向剤は、 重合体として脂環式構造を有する可溶性ポリイミドを含 むことを特徴とするが、ポリアミック酸および/または 他の構造のポリイミドを混合して用いることもできる。 中でも、ポリアミック酸とポリイミドとを混合して用い ると、得られる液晶表示素子の残像特性が特に良好とな り、好ましい。

【0043】重合体を溶解させる有機溶媒としては、重 合体を溶解できるものであれば特に制限されるものでは なく、例えばポリアミック酸の合成反応や脱水閉環反応 に用いられるものとして例示した溶媒を挙げることがで きる。また、ポリアミック酸の合成反応の際に併用する ことができるものとして例示した貧溶媒も適宜選択して 併用することができる。

【0044】本発明に用いられる液晶配向剤は、重合体 と塗布される基板表面との接着性を更に向上させる観点 から、官能性シラン含有化合物やエポキシ化合物が配合 されていてもよい。このような官能性シラン含有化合物 としては、例えば3-アミノプロピルトリメトキシシラ ン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、2-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、2-アミノプロピルト リエトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-ア ミノプロピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエ チル) -3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 3ーウレイドプロピルトリメトキシシラン、3ーウレイ ドプロピルトリエトキシシラン、N-エトキシカルボニ

ン、Nートリエトキシシリルプロピルトリエチレントリ アミン、Nートリメトキシシリルプロピルトリエチレン トリアミン、10ートリメトキシシリルー1.4.7ート リアザデカン、10-トリエトキシシリル-1,4,7-トリアザデカン、9ートリメトキシシリルー3,6ージ アザノニルアセテート、9ートリエトキシシリルー3, 6-ジアザノニルアセテート、N-ベンジル-3-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、N-ベンジルー3-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-フェニル-3 -アミノプロピルトリエトキシシラン、N-ビス (オキ シエチレン) -3-アミノプロピルトリメトキシシラ ン、N-ビス (オキシエチレン) -3-アミノプロピル トリエトキシシランなどを挙げることができる。

【0045】また、エポキシ基含有化合物としては、例 えばエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエ チレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレング リコールジグリシジルエーテル、トリプロピレングリコ ールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコール 30 ジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリ シジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジ ルエーテル、グリセリンジグリシジルエーテル、2,2 ージブロモネオペンチルグリコールジグリシジルエーテ ル、1,3,5,6ーテトラグリシジルー2,4ーヘキサン ジオール、N,N,N',N',ーテトラグリシジルーm-キシレンジアミン、1,3ービス(N.Nージグリシジル アミノメチル) シクロヘキサン、N,N,N',N',-テ トラグリシジルー4、4'ージアミノジフェニルメタ ン、3-(N-アリル-N-グリシジル)アミノプロピ ルトリメトキシシラン、3-(N,N-ジグリシジル) アミノプロピルトリメトキシシランなどを好ましいもの として挙げることができ、これらのうち、分子内に、3 級窒素原子を有する化合物が好ましい。これらの化合物 の配合割合は、重合体100重量部に対して、通常、4 0重量部以下、好ましくは0.1~30重量部である。 【0046】 [液晶表示素子の作製] 本発明における液 晶配向剤を用いて得られる液晶表示素子は、例えば次の

(1) パターニングされた透明導電膜が設けられた基板 ルー3ーアミノプロピルトリメトキシシラン、N-エト※50 の透明導電膜側に、液晶配向剤を、例えばロールコータ

方法によって製造することができる。

ー法、スピンナー法、印刷法などの方法によって塗布 し、次いで塗布面を加熱することにより被膜を形成す る。ここに基板としては、例えばフロートガラス、ソー ダガラスなどのガラス、ポリエチレンテレフタレート、 ポリブチレンテレフタレート、ポリエーテルスルホン、 ポリカーボネートなどのプラスチックフィルムなどから なる透明基板を用いることができる。基板の一面に設け られた透明導電膜としては、SnO2からなるNESA 膜、In2O3-SnO2からなるITO膜などを用いる ことができ、これらの透明導電膜のパターニングには、 フォト・エッチング法、予めマスクを用いる方法などが 用いられる。

【0047】液晶配向剤の塗布に際しては、基板および 透明導電膜と塗膜との接着性をさらに良好にするため に、基板および透明導電膜上に、予め官能性シラン含有 化合物、チタネートなどを塗布することもできる。また 加熱温度は、好ましくは80~250℃とされ、より好 ましくは120~200℃とされる。形成される被膜の 膜厚は、通常0.001~1μm、好ましくは0.005 ~0.5µmである。形成された被膜は、被膜表面にイ オンビームを照射することにより、液晶分子の配向能が 被膜に付与されて液晶配向膜となる。イオンビームのイ オン種としては、窒素、ヘリウム、アルゴン、ネオンな どの不活性ガスのイオンビームを用いることが好まし い。また、イオンビーム照射時あるいは照射後に、イオ ン中和のための電子を供給することが好ましい。

【0048】イオンビームの照射は、基板上の被膜に対 し、基板からの角度が例えば10~80度となる方向か ら行うことができる。その際、イオンビームの加速電圧 としては例えば50~500 Vとすることができる。照 射時間は、加速電圧や被膜厚によっても異なるが、通常 1~60秒程度で十分である。

【0049】また、上記処理により形成された液晶配向 膜に、例えば特開平8-234207号公報、特開平7 -168187号公報、特開平6-222366号公報 や特開平6-281937号公報に示されているよう な、紫外線、イオンビーム、電子ビームを部分的に照射 することによってプレチルト角を変化させるような処 理、あるいは特開平5-107544号公報に示されて いるような、上記配向処理された液晶配向膜上にレジス 40 ト膜を部分的に形成し、先行の液晶配向方向とは異なる 方向に配向処理を行った後、前記レジスト膜を除去し て、液晶配向膜の配向能を変化させるような処理を行う ことによって、液晶表示素子の視界特性を改善すること が可能である。

【0050】(3)上記のようにして液晶配向膜が形成 された基板を2枚作成し、それぞれの液晶配向膜におけ るプレチルト角の方向が直交または逆平行となるよう に、2枚の基板を間隙(セルギャップ)を介して対向さ せ、2枚の基板の周辺部をシール剤を用いて貼り合わ

24 せ、基板の表面およびシール剤により区画されたセルギ ャップ内に液晶を充填し、充填孔を封止して液晶セルを 構成する。そして、液晶セルの外表面、すなわち、液晶 セルを構成するそれぞれの基板の他面側に、偏光板を、 その偏光方向が当該基板の一面に形成された液晶配向膜 の液晶配向方向と一致または直交するように貼り合わせ ることにより、液晶表示素子が得られる。上記シール剤 としては、例えば硬化剤およびスペーサーとしての酸化 アルミニウム球を含有したエポキシ樹脂などを用いるこ 10 とができる。

【0051】上記液晶としては、例えばネマティック型 液晶、スメクティック型液晶を挙げることができる。そ の中でもネマティック型液晶が好ましく、例えばシッフ ベース系液晶、アゾキシ系液晶、ビフェニル系液晶、フ ェニルシクロヘキサン系液晶、エステル系液晶、ターフ ェニル系液晶、ビフェニルシクロヘキサン系液晶、ピリ ミジン系液晶、ジオキサン系液晶、ビシクロオクタン系 液晶、キュバン系液晶などが用いられる。また、これら の液晶に、例えばコレスチルクロライド、コレステリル ノナエート、コレステリルカーボネートなどのコレステ リック液晶や商品名「C-15」、「CB-15」(メ ルク社製)として販売されているようなカイラル剤など を添加して使用することもできる。さらに、pーデシロ キシベンジリデンーpーアミノー2-メチルブチルシン ナメートなどの強誘電性液晶も使用することができる。 【0052】また、液晶セルの外側に使用される偏光板 としては、ポリビニルアルコールを延伸配向させなが ら、ヨウ素を吸収させたH膜と呼ばれる偏光膜を酢酸セ ルロース保護膜で挟んだ偏光板またはH膜そのものから 30 なる偏光板などを挙げることができる。

[0053]

【実施例】以下、本発明を実施例により、さらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限されるも のではない。以下の実施例および比較例により作製され た各液晶表示素子における評価方法を以下に示す。

【0054】 [液晶の配向性]液晶表示素子に電圧をオ ン・オフさせた時の液晶セル中の異常ドメインの有無を 顕微鏡で観察し、異常ドメインのない場合を「良好」と 判断。 液晶表示素子作製直後と、素子を1週間100 ℃オーブン中で保管後の2時点で調べた。

【0055】 [液晶表示素子の残像消去時間]液晶表示 素子に直流電圧5Vを24時間印加した後電圧をOFF とし、目視で残像が消去するまでの時間を測定した。

【0056】 [液晶表示素子の電圧保持率]液晶表示素 子に5Vの電圧を60マイクロ秒の印加時間、500ミ リ秒のスパンで印加した後、印加解除から500ミリ秒 後の電圧保持率を測定した。測定装置は(株)東陽テク ニカ製VHR−1を使用し、60℃で行った。

【0057】 [液晶表示素子のプレチルト角] 「T.J. 50 Schffer, et.al., J. Appl. Phys., v

o1.19,2013 (1980)」に記載の方法に準拠 し、He-Neレーザー光を用いる結晶回転法により測 定した。

【0058】合成例1

2,3,5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物 224.17g(1.00モル)、p-フェニレンジアミ ン97.33g(0.90モル)および上記式(17)で 表される3,5-ジアミノ安息香酸コレステリル52.0 $8g(0.10 \pm h) \times N - x + h - 2 - U + U + V = 2$ せた。次いで、得られた反応溶液を大過剰のアセトンに 注いで反応生成物を沈澱させた。得られた重合体30. 0gを γ -ブチロラクトン570gに溶解させ、ピリジ ン32gおよび無水酢酸24gを添加して110℃で4 時間脱水閉環させた。次いで、反応生成物の沈殿・分離 ・洗浄・乾燥を行うことにより、対数粘度(カ1n) 1.36 d l / g、イミド化率=95%の可溶性ポリイ ミド重合体(A) 27.3gを得た。

【0059】合成例2

1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒドロ-8-メチル-5-(テトラヒドロー2,5-ジオキソー3-フラニ ル) -ナフト[1,2-c]フラン-1,3-ジオン31 4.30g(1モル)、p-フェニレンジアミン91.8 8g(0.85モル) および化学式(20) で表される 化合物63.36g(0.15モル)をN-メチル-2-ピロリドン1900gに溶解させ、この溶液を20℃で 26時間反応させた。次いで、得られた反応溶液を大過 剰のアセトンに注いで反応生成物を沈澱させた。得られ た重合体30.0gをアーブチロラクトン270gに溶 解させ、ピリジン20gおよび無水酢酸45gを添加し 30 て80℃で4時間脱水閉環させた。次いで、反応生成物 の沈殿・分離・洗浄・乾燥を行うことにより、対数粘度 (nln)1.06dl/g、イミド化率=100%の 可溶性ポリイミド重合体(B)28.3gを得た。

【0060】合成例3

合成に用いる原料を、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサ ヒドロー8-メチルー5ー(テトラヒドロー2,5-ジ オキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]フラン -1,3-ジオン314.30g(1モル)、4,4'-ジアミノジフェニルメタン29.75g(0.15モ (0.70 ± 1.00) ル) および化学式 (20) で表される化合物63.36 g(0.15モル)に変更する以外は合成例2と同様に 反応を行い、対数粘度(n l n) 1.0 d l / g、イミ ド化率=100%の可溶性ポリイミド重合体(C)2 5.3gを得た。

【0061】合成例4

ピロメリット酸二無水物218.1g(1モル)および 4,4'-ジアミノジフェニルメタン198.27g (1.00モル)をN-メチル-2-ピロリドン160

0gに溶解させ、この溶液を20℃で6時間反応させ た。次いで、得られた反応溶液を大過剰のアセトンに注 いで反応生成物を沈澱させて反応生成物の沈殿・分離・ 洗浄・乾燥を行うことにより、対数粘度(カ1n)1. 8dl/gのポリアミック酸重合体(D)400.3g を得た。

26

【0062】合成例5

2.3.5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物 224.17g(1.00モル) およびピス[4-(4-100gに溶解させ、この溶液を40℃で6時間反応さ 10 アミノフェノキシ)フェニル]スルフォン432.5g $(1.00 \pm \mu)$ を γ -ブチロラクトン6000gに溶 解させ、この溶液を60℃で6時間反応させた。次い で、得られた反応溶液を大過剰のアセトンに注いで反応 生成物を沈澱させて反応生成物の沈殿・分離・洗浄・乾 燥を行うことにより、対数粘度(カIn)1.5dl/ gのポリアミック酸重合体(E)650gを得た。

【0063】合成例6

合成に用いる原料を、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサ ヒドロー8ーメチルー5ー (テトラヒドロー2.5ージ 20 オキソー3-フラニル)ーナフト[1,2-c]フラン -1,3-ジオン314.30g(1モル)、p-フェニ レンジアミン86.47g(0.8モル)および化学式 (20)で表される化合物63.33g(0.15モ ル)、3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン1 9.09g(0.05モル)に変更する以外は合成例2と 同様に反応を行い、対数粘度(カ1n)0.94d1/ g、イミド化率=100%の可溶性ポリイミド重合体 (F) 25gを得た。

【0064】合成例7

合成に用いる原料を、ピロメリット酸二無水物109. 14g、シクロブタンテトラカルボン酸無水物98.1 4g、4,4'-ジアミノジフェニルメタン190.41 g、3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン19. 31gに変更する以外は合成例4と同様に反応を行い、 対数粘度(nln)0.94dl/gの重合体(B)2 5gを得た。乾燥を行うことにより、対数粘度 (ヵ1 n) 1.6 d l/gのポリアミック酸重合体 (G) 41 0gを得た。

【0065】合成例8

40 重合体(E)50gをァーブチロラクトン900gに溶 解させ、ピリジン30gおよび無水酢酸23gを添加し て110℃で4時間脱水閉環させた。次いで、反応生成 物の沈殿・分離・洗浄・乾燥を行うことにより、対数粘 度(n l n) 1.3 d l / g 、 イミド化率= 9 8 %の可 溶性ポリイミド重合体(H)48.3gを得た。

【0066】合成例9

2.3.5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物 257g、pーフェニレンジアミン93gおよび上記式 (16)で表される化合物150gをN-メチル-2-50 ピロリドン2800gに溶解させ、この溶液を60℃で

6時間反応させた。次いで、得られた反応溶液を大過剰 のアセトンに注いで反応生成物を沈澱させた。得られた 重合体30.0gを γ -ブチロラクトン400gに溶解 させ、ピリジン17gおよび無水酢酸11gを添加して 110℃で4時間脱水閉環させた。次いで、反応生成物 の沈殿・分離・洗浄・乾燥を行うことにより、対数粘度 (カln) 1.06 dl/g、イミド化率=80%の可 溶性ポリイミド重合体(I)28.3gを得た。

【0067】実施例1

重合体Aをケーブチロラクトンに溶解させて、固形分濃 10 度4重量%の溶液とし、この溶液を孔径1μmのフィル ターで沪過し、液晶配向剤を調製した。 この液晶配向 剤を、液晶配向膜塗布用印刷機を用いて I TO膜からな る透明電極付きガラス基板の透明電極面に塗布し、18 0℃のホットプレート上で20分間乾燥し、乾燥平均膜 厚900オングストロームの被膜を形成した。この被膜 に基板からの角度が40°となる方向から、アルゴンイ オンビームを200Vの加速電圧で、10秒間照射し た。

の液晶配向膜を有するそれぞれの外縁に、直径5.5μ mの酸化アルミニウム球入りエポキシ樹脂接着剤をスク リーン印刷塗布した後、一対の液晶挟持基板を液晶配向 膜面が相対するように、しかもイオンビーム照射方向が 直行するように重ね合わせて圧着し、接着剤を硬化させ た。

【0069】次いで、液晶注入口より一対の基板間に、 ネマティック型液晶(メルク社製、MLC-5081) を充填した後、アクリル系光硬化接着剤で液晶注入口を 封止し、基板の外側の両面に偏光板を、偏光板の偏光方 向がそれぞれの基板の液晶配向膜のイオンビーム照射方 向と一致するように張り合わせ、液晶表示素子を作製し た。

【0070】得られた液晶表示素子の液晶の配向性、プ レチルト角、電圧保持率および残像消去について評価を 行ったところ、液晶の配向性は初期、高温保管後共に良 好で、残像消去時間は1分と小さい値であった。これら の結果を表1に示す。実施例2~10、比較例1~3 【0071】表1に示す処方に従い、合成例1~8で得 られた重合体、添加剤を用いた液晶配向剤を調整し、実 施例7において液晶をMLC-2012に変更した以外 は、実施例1と同様に配向処理を行い、実施例1と同様 にして液晶表示素子を作製した。得られた液晶表示素子 【0068】次に、一対の配向処理された液晶挟持基板 20 の各々について、液晶の配向性、残像消去時間などにつ いて評価した。結果を表1に示す。

> [0072] 【表1】

2	a
_	"

来 (1 1 1 1 1 1 1 1 1	承 (来 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
╌╋╌┡═┝╌╄╼┨┈╂╌┋═╏╌┈╸╏			(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
			00000000000000000000000000000000000000
	တြုတ္ခုတ္ခုတ္ခုတ္ခုတ္က တြဲ ျပ		
	9, 9, 9, 9, 0,		
 	1 1 1 1 1 1		
9 K 0 4 10			
0 6 4 IC	0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 4 0 4	2 4 2 2 2 2 4
良好 良好			(E)
B B(5) B(4) B(4) B(4) B(4) B(4) B(4) B(4) B(4			
8 0 2 H B 2 D B B B B B B B B B B B B B B B B B			
	良好	良好良好	良好 度好 流動配向 あり

【0073】本発明によれば、イオンビーム法による配 向処理において、従来問題となっていた配向不良、残像 特性を、改良することができる。 従って、従来からの ラビング法に代わる簡便で、クリーンな条件下で液晶表 示素子作製が可能となり、ラビングダストによる歩留ま り低下の問題が完全に解消される。

【0074】本発明方法により調製した液晶配向膜を有 する液晶表示素子は、ラビング法と同等の配向性、残像 特性を示すことから、TN型およびSTN型液晶表示素*50 板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピューター、液

*子に好適に使用できる以外に、使用する液晶を選択する ことにより、SH (Super Homeotropi c)型、IPS (In-Plane Switchin g)型、強誘電性および反強誘電性の液晶表示素子など にも好適に使用することができる。

【0075】さらに、本発明方法により調製した液晶配 向膜を有する液晶表示素子は、種々の装置に有効に使用 でき、例えば卓上計算機、腕時計、置時計、係数表示

晶テレビなどの表示装置に用いられる。